公司代码:688720 公司简称:艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析:四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。截至2026年4月24日,公司总股本88,133,334股,扣除目前回购专户的股份余额1,144,032股后参与分配股数共86,989,302股,以此计算合计拟派发现金红利9,568,823.22元(含税),占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.68%。

公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2026年4月24日,公司总股本88,133,334股,本次转增股本后,公司的总股本为122,929,054股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系四舍五入所致)。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,144,032股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

以上利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	艾森股份	688720	/

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小华	徐莹
联系地址	江苏省昆山市千灯镇中庄路299号	江苏省昆山市千灯镇中庄路299号
电话	0512-50103288	0512-50103288
传真	0512-50103111	0512-50103111
电子信箱	ir@asem.cn	ir@asem.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务基本情况

作为国内半导体材料领域的领军企业,公司始终锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道,以技术创新为核心驱动力深耕行业多年。凭借持续高强度的研发投入与关键技术突破,公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案体系,不仅在半导体封装化学品领域实现对国外供应商的规模化替代,成长为国内市场的核心主力供应商,更在晶圆制造领域已实现深度卡位,通过电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心业务板块,为先进制程芯片制造提供关键材料支撑,同时逐步向半导体显示及IC载板等高附加值领域延伸。目前,公司已成为国内少数具备半导体封装、晶圆制造和半导体显示全链条电子材料供应能力的企业,为我国半导体产业的自主可控发展提供关键支撑。

2、主营产品基本情况

(1)电镀液

电镀液是半导体制造过程中的核心材料之一,由主盐、导电剂及多种功能性电镀添加剂组成,其中电镀添加剂是调控镀层均匀性、致密性及微观形貌的关键核心,直接决定电镀工艺的最终性能表现。随着半导体器件特征尺寸持续微缩至5nm及以下制程,以及先进封装技术如3D IC、Chiplet的快速迭代,不同应用场景对电镀液的配方精准度、杂质控制水平及性能适配性提出了严苛要求。公司凭借深厚的技术积累,打造了覆盖传统封装、先进封装、晶圆制造及玻璃基板、IC载板、HDI等全应用领域的电镀液产品矩阵,可针对不同工艺节点与封装形式提供定制化解决方案,满足半导体产业链各环节的高端制造需求。

传统封装领域,公司的电镀液产品主要应用于芯片引脚表面镀锡,主要为基于甲基磺酸的电镀体系。作为业务起点,公司传统封装用电镀液产品已完成全面国产化替代。引脚线镀锡电镀液系列产品市场占有率持续领先,确立了公司在传统封装材料市场的主导地位。

先进封装领域,随着集成电路向高密度、高性能方向演进,先进封装技术成为产业升级的核心驱动力。互连层数的持续增加,以及RDL(再布线层)、铜柱等结构的广泛应用,推动铜互连材料需求快速增长;同时,2.5D/3D集成封装(包括HBM封装、CoWoS封装等形式)、混合键合(Hybrid Bonding)、玻璃基板封装等尖端技术路线不断涌现,对电镀材料的配方精准度、工艺适配性提出了严苛要求。公司前瞻性布局先进封装全工艺链条,构建起覆盖硅通孔(TSV)、再布线层(RDL)、微凸点(Bumping)等核心工艺的完整产品矩阵。目前,高纯硫酸铜基液已实现先进封装头部客户的稳定供应,另有多项前沿产品已进入商业化关键阶段:电镀锡银添加剂(包括超低α粒子的锡浓缩液、锡阳极)小批量稳定量产,并在多家头部客户同步验证中;电镀铜添加剂处于关键批次稳定性验证阶段;TSV电镀添加剂在客户端测试验证中。

晶圆制造领域,全球半导体产业加速向5nm及以下先进制程演进,晶圆制造关键材料国产替代需求愈发迫切,大马士革工艺是实现高密度铜互连的核心技术,直接决定芯片的性能与良率。公司大马士革电镀铜添加剂覆盖7-55nm全制程节点,确保铜互连具有优异的填充能力与低缺陷率,可满足不同客户的工艺需求;针对5-14nm节点对互连阻抗和可靠性的更高要求,公司钴制程电镀液提供优异的电迁移耐受性与界面稳定性。目前公司28nm大马士革铜互连工艺电镀铜添加剂,5-14nm钴制程电镀基液已在主流晶圆客户端小批量量产中,同步在头部存储客户端验证顺利;适应不同深宽比孔型的TSV工艺高速镀铜添加剂也在客户端验证中。

HDI、IC载板、玻璃基板领域,随着AI芯片、汽车及消费电子驱动先进封装需求攀升,其市场规模也快速扩容。公司精准把握技术升级与国产替代的双重市场机遇,将电镀铜产品逐步推向HDI、SLP、IC载板、玻璃基板等高端应用领域,有效提高国产化率。目前,公司快速填孔镀铜产品已成功导入头部HDI和SLP供应链,实现批量供货。针对IC载板兼具高均匀性与精细图形能力的电镀工艺要求,公司专门开发了高均匀性填孔电镀液,可同时满足微孔填充与图形电镀的双重需求,大幅提升产品一致性与良率。公司MSAP用电镀配套试剂已在IC载板客户端实现批量供货,MSAP用填孔镀铜产品目前正处于IC载板客户端测试阶段;公司TGV镀铜添加剂应用于玻璃基板通孔技术中,亦在配合头部玻璃基板客户测试。

凭借持续的技术积累和突破,公司产品能够在不同制程节点和封装形式下为客户提供稳定、优异的电镀性能支持,助力半导体产业向更高性能、更高集成度、更高自主可控水平持续迈进。

②配套试剂

集成电路或电子元件在进入电镀前的加工处理和清理工序总称为电镀前处理。公司提供的电镀前处理化学品包括祛毛刺液、除油剂、活化剂等。在电镀后的加工处理和清理工序总称为电镀后处理。公司提供的电镀后处理化学品包括中和剂、退镀剂等。

晶圆制造大马士革铜互联制程中,大马士革电镀后通过CMP(化学机械研磨)平坦化,研磨后需要清洗表面去除研磨粒子和其他颗粒。公司应用在技术节点28nm铜制程清洗液已进入量产放大阶段;新一代PCMP产品应用于技术节点7nm钴先进制程清洗液在客户端验证阶段。

(2)光刻胶及配套试剂

公司构建了从特色光刻胶、光刻胶核心原材料到配套试剂的完整研发制造体系,产品覆盖半导体全产业链应用场景,多项技术填补国内空白。

①光刻胶

光刻胶按应用领域可分为PCB光刻胶、显示面板光刻胶和集成电路光刻胶(含先进封装、晶圆制造),其技术壁垒依次提升。国产光刻胶发展起步较晚,目前仍以PCB光刻胶、TFT-LCD光刻胶等中低端产品为主,集成电路光刻胶及OLED显示面板光刻胶长期被国外企业占据。

公司以先进封装光刻胶、晶圆制造PSPI以及OLED阵列制造用光刻胶等特色工艺光刻胶为突破口,覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域,成功打破国外垄断,并逐步向先进制程延伸,如IC A光刻胶、KrF光刻胶等。

先进封装领域,公司凭借技术与客户资源优势,已构建起极具竞争力的光刻胶产品矩阵,涵盖可应用于GHI-line、I-line光源的光刻胶产品,包括正性、化学放大型光刻胶及负性光刻胶,不同产品膜厚兼容7-300μm,在Bumping、RDL、TSV、fine pitch RDL、μBumping、μPad、Mega-Bumping等先进封装核心工艺环节,正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。同时,公司正加速推进用于Bumping、WLCSP、2.5D/3D封装的PSPI的验证与量产,产品包括高温固化、低温固化、超低温固化系列,其中低温PSPI在客户端小量产中,具备低应力、高可靠性及高分辨率的PSPI产品在客户端验证中。公司目标成为国内先进封装光刻胶和PSPI领域的主力供应商,全面提升国产光刻材料的市场渗透率。

晶圆制造领域,具有化学放大效能的I-Line光刻胶系列产品及可应用于功率器件的PSPI已实现小批量供货,并同步在多家头部客户,包括存储芯片厂商推广验证中。高深宽比KrF光刻胶(深宽比达13:1)目前在客户端验证阶段,在高厚膜下,通过优化树脂和PAG,提升分辨率,相应提高光刻胶深宽比,主要应用在CIS芯片、存储芯片中,力求填补国内空白。

半导体显示领域,公司OLED阵列用高感度PFAS Free正性光刻胶,已顺利通过了头部面板客户的验证,并取得小批量量产订单,在多家OLED显示客户端同步验证中。另外公司在特色工艺光刻胶领域取得突破:负性光刻胶已成功拓展至玻璃基封装应用场景,获得头部客户量产订单。

②配套试剂

先进封装要求在晶圆划片前融入封装工艺步骤,具体包括晶圆研磨薄化、RDL、Bumping及TSV等工艺技术,涉及与晶圆制造相似的涂胶、显影、去胶、蚀刻等工序步骤。公司应用于先进封装领域光刻胶配套试剂已形成规模化供应,主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。

在晶圆制造领域,公司针对先进技术节点,用于光刻胶干法蚀刻后残留物去除的清洗液(PERR),适用铜/钴互联制程,正在晶圆客户端验证中。

③光刻胶用树脂

感光树脂构成光刻胶的基本骨架,主要决定曝光后光刻胶的基本性能,包括硬度、柔韧性、附着力、曝光前和曝光后对特定溶剂的溶解度。公司由自研树脂团队开发光刻胶用树脂,形成了从树脂分子结构设计、合成、纯化,到光刻胶配方开发、工艺验证的完整全链条研发制造体系,确保后续产品供应的自主可控与稳定性。目前公司自研光刻胶用树脂覆盖多品类需求:包括负性光刻胶的丙烯酸树脂,化学放大光刻胶和KrF光刻胶的聚对羟基苯乙烯树脂,PSPI光刻胶的聚酰胺酯/聚酰胺酸/PBO树脂,以及TSV等特殊应用的化学放大光刻胶酚醛改性树脂等,为光刻胶产品的性能提升与成本控制奠定核心基础。

(3)电镀配套材料

除电子化学品外,公司还可以提供电镀工艺配套的锡球、镍供等阳极金属材料及阳极袋、退镀用胶条等辅材,以满足客户的整体需求。公司销售的锡球主要采用外协加工模式。

2.2主要经营模式

1、销售模式

公司产品销售为直销模式。公司建立了较为完善的市场营销体系,与国内多家知名半导体封测厂商、晶圆制造厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司的产品销售流程包括了解客户需求、取得测试机会、通过客户认证、通过终端客户测试(如有)、小规模量产(如有)及批量供货。

公司有能力为客户提供Turnkey整体解决方案,即除了提供实现特定功能相匹配的电子化学品及配套材料外,还能够提供与产品相适应的应用工艺方案和技术支持等,使得相关产品能够适配不同客户的产线标准和生产工艺,满足下游产品的功能、质量要求。

按照公司向客户交货及结算模式,可以分为非寄售模式和寄售模式两类。非寄售模式下,根据销售合同或订单约定,公司将商品发运至客户指定地点并经客户确认收货时实现销售;寄售模式下,公司根据销售合同或订单的约定将商品发运至客户指定地点,在客户实际领用时实现销售。

2、采购模式

采购环节是公司品质控制和成本控制的关键环节。公司制定了《采购控制程序》《供应商管理办法》等制度对采购活动进行严格控制。

采购管理部负责开发供应商,组织对供应商的评审,建立合格供应商名录和档案,定期对供应商进行评定,及时调整合格供应商名单,实施动态管理。采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等向供应商下发采购订单。公司基于市场行情、向供应商询价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

3、生产模式

公司主要按照以销定产的总体原则安排生产计划,分为按计划生产和按需生产两种生产模式。

在按计划生产的模式下,公司根据客户销售需求,综合考虑安全库存量和生产能力,制定生产计划。计划人员会根据近三个月的销售情况与销售部门确认后制定生产计划,一般情况下公司制定的生产计划能够满足客户的定期下单需求。按需生产的模式,是指在客户临时加单的情况下,公司根据临时加单的需求,针对性安排额外的生产计划。

4、研发模式

公司研发流程主要包括以下过程:

(1)研发立项阶段

研发部门设立年度/月计划,以对研发项目实施总体规划。研发项目因市场调研情况及产品规划开立课题,由各产品事业部或研发部负责人收集信息、分析需求,并出具相关的需求报告,经研发总监或总经理审核通过后提交管理层会议审议,审议通过后进行相应的项目立项。项目通过可行性评估后,签发研发任务给到研发部。研发部负责人确定项目负责人,研发任务转化为研发计划。

(2)研发需求确认阶段

项目负责人根据研发计划的规划,确定研发的需求,主要包括以下内容:①产品的主要性能指标,主要来源于应用需求;②法律法规及国家相关强制性标准;③历史类似研发项目积累的适用信息;④新产品安全性和适用性至关重要的特性要求,如安全、包装、运输、贮存、环境、卫生等。

(3)产品设计及实验室小试阶段

项目负责人根据研发需求,在实验室内组织开展配方设计及测试评估工作,并根据测试结果优化调整配方。

(4)样品试制及研发验证阶段

研发部组织有关部门评审研发项目的阶段性结果。研发部负责人负责审核样品试制技术要求,并核准试制样品。试制完成的样品由研发部安排进行产品性能验证,样品检验合格的进入下一研发阶段。如不合格,研发部门分析技术原因,并重新试制或变更配方设计。

为确保产品能够满足客户的使用及预期用途要求,公司送样至客户现场,使用客户的产线资源对样品进行验证。

(5)中试及产品认证阶段

研发部门完成工艺标准和控制标准的制定,并根据研发验证结果持续优化和调整产品,直至研发成果通过客户实际产线测试,完成最终产品认证。

2.3所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司产品广泛应用于集成电路、半导体显示及新型电子元器件等行业。按照行业的一般分类标准,公司所处行业为半导体材料行业。

1、行业发展阶段

当前中国半导体材料行业整体处于?由中低端替代向高端突破演进?的关键阶段,也是国产化替代的黄金期。在政策支持、产业链自主可控需求及下游晶圆厂扩产的多重驱动下,国产化进程明显提速。在封装材料领域?,传统封装材料基本实现国产化,而?先进封装用光刻胶、TSV填充材料、玻璃基板?等成为新一轮技术竞争焦点。在制造材料领域,湿电子化学品、CMP材料等已实现14nm及以上节点的批量供应,部分产品进入7nm制程验证阶段。

公司所聚焦的?光刻胶与电镀液?,正是国产化率最低、技术门槛最高的“卡脖子”环节之一。公司通过持续研发投入与技术攻关,目前在先进封装光刻胶、晶圆制造电镀液等领域已实现从“0到1”的突破,正迈向规模化替代的新阶段。随着存储芯片行业景气度的持续提高以及国内厂商国产替代进程的持续加速,上游材料环节迎来量价齐升机会,公司电镀液和光刻胶处于国内第一梯队,将直接受益。

2、行业基本特点

公司所处的半导体材料行业,始终是国家重点支持与鼓励发展的战略性行业。国家通过“十四五”“十五五”规划将新材料尤其是半导体关键材料列为战略攻坚方向,加速推进国产化,推动供应链自主可控。在产业政策的有力引导下,行业将迎来更为广阔的发展空间,为企业创新发展和产业升级提供坚实保障。半导体材料处于整个电子产业的最上游,具有技术壁垒高、研发投入大、认证周期长、客户粘性强等特点。发展受下游应用如AI、自动驾驶、数据中心等新兴需求驱动,呈现持续迭代趋势。

3、主要技术门槛

半导体材料作为集成电路制造的基础支撑产业,是典型的技术密集型行业。其技术壁垒贯穿材料研发、生产制备、客户验证及供应链协同全流程,核心体现为对材料性能极致化、生产工艺精细化、质量控制严苛化的要求,以及由此延伸的认证、资金、知识产权等多重门槛,共同构成行业准入的核心壁垒。

①复杂的化学配方与材料设计?

光刻胶?需在特定波长光照下实现精确的溶解度变化,其配方由?光引发剂、树脂、单体、溶剂和助剂?组成,各组分比例需精细调控。研发高度依赖“试错式”实验积累。电镀液?用于铜互连、凸点封装等关键工艺,需实现?高深宽比结构的无空穴填充?。其添加剂体系(如加速剂、抑制剂、均镀剂)需协同作用,确保沉积均匀性与致密性。例如,28nm以下制程要求电镀铜层在深宽比达10:1以上的通孔中完全填满,对配方调控精度要求极高。

②极致的纯度与稳定性要求

光刻胶中金属离子含量必须控制在?ppb级甚至ppt级,否则会引入杂质导致芯片电学性能下降。例如,适用于晶圆制造的光刻胶产品对金属离子含量要求可达到低于1ppb,需通过多级提纯与超净环境生产实现。电镀液中的微小颗粒或有机污染会导致镀层缺陷,影响互连可靠性。生产过程需在?Class 10以下超净车间?进行,并配备在线过滤与实时监测系统,确保批次间一致性。

③严苛的工艺适配与客户认证周期

半导体材料需通过下游芯片制造企业的严格认证才能进入供应链,认证周期通常为2-5年,涵盖小批量试产、中试验证、可靠性测试及量产稳定性考核等环节。客户需对材料的纯度、批次稳定性、工艺兼容性及长期可靠性进行全场景测试,对于28nm以下先进制程材料,认证更为复杂,往往需与芯片厂联合调试,完成?数十轮工艺适配与配方优化?,确保材料能精准匹配产线工艺窗口。一旦通过认证,客户不会轻易更换供应商,避免工艺波动与良率风险,这种高粘性格局,使得现有供应链极为稳固,新进入者面临巨大突破难度。

④高昂的研发投入

一是研发周期跨度长,多数项目从立项到商业化落地需3-5年,部分技术难度高项目周期超5年,持续技术攻关、方案迭代与反复性能测试,均需稳定的资金供给以保障研发连续性;二是研发团队规模大,涵盖基础研究、应用开发、测试验证等全流程专业人才,且人才激励投入高;三是核心实验设备成本高,光刻机、电化学工作站等高精度仪器设备购置及维护、校准、升级需长期资金保障;四是研发耗材消耗大,专用耗材单价高、消耗快,尤其是在实验验证阶段消耗量剧增。

⑤严密的专利与技术封锁?

国际巨头在半导体材料领域布局了密集的知识产权网络,涵盖材料配方、制备工艺、应用技术等多个维度,拥有数千项核心专利,形成严密技术护城河。国内企业需通过自主研发突围,公司已累计申请光刻胶相关发明专利?2项(授权35项),覆盖负性光刻胶、PSPI、KrF等高端产品线。伴随摩尔定律推进,芯片制程持续升级,材料技术需同步迭代,企业需持续研发以保持领先,知识?产权壁垒也随技术演进不断强化。

尽管?临森严,但在国产替代加速背景下,公司在先进封装和晶圆制造用电镀液与光刻胶领域已实现突破,部分产品进入批量供应阶段,逐步打破海外垄断格局。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为第一批国家级专精特新“小巨人”企业,目前已是国内半导体材料领域的核心供应商。公司聚焦“电镀液+光刻胶”双核心赛道,在国产化率最低、技术壁垒最高的关键环节持续突破,成为高端电子化学品国产替代的核心力量。

电镀液业务是公司的业绩基本盘,在封装领域市占率约30%,牢牢占据市场主导地位,在先进封装领域,公司能够提供从电镀液到配套试剂的整体解决方案,产品覆盖HBM、3D堆叠芯片等高端封装形式的核心工艺环节,可满足凸块制作、通孔填充、铜互连等复杂制程需求。凭借“电镀+光刻”双工艺协同优势,公司深度绑定国内先进封装龙头企业,成为先进封装领域电镀液的主力供应商之一,充分受益于高算力需求驱动的先进封装市场扩容。在晶圆制造领域,公司已跻身国内电镀液供应商第一梯队,尤其在先进制程领域处于国内前列,产品覆盖28nm、14nm及以下先进制程的全链条需求,主要服务于国内头部晶圆厂和存储厂。

光刻胶业务是公司的核心增长极,在先进封装光刻胶领域,公司已构建完整产品矩阵,是国内该领域的龙头企业;在晶圆制造光刻胶领域,公司是国产化的开拓者,正性PSPI实现国内首例量产,多款高端光刻胶产品填补国内技术空白,进一步提升了公司在晶圆制造光刻胶领域的话语权。目前,A1态片、高带宽存储(HBM)、数据中心光互联(CPO)等市场持续快速扩张。在三维集成与先进封装行业的高速发展下,先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑已发生根本性转变。过去,光刻胶需求主要跟随封装产量线性增长;如今,堆叠层数每翻一番,光刻工艺次数便大致翻倍,形成超线性增长的乘数效应。HBM正从8层向12层、16层演进,SK海力士已展出全球首款16层HBM4样品。每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺,堆叠层数的指数级增长,直接驱动光刻胶及配套试剂的需求量呈超线性扩张。先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑,已从线性增长彻底转向以堆叠层数为自变量的超线性扩张新范式。而当前国内半导体光刻胶的国产化率不足20%,先进封装和晶圆领域先进节点的光刻胶基本被国际巨头垄断,国产替代需求迫切。公司凭借在光刻胶领域的技术突破和产品布局,成为国产替代浪潮中的核心受益企业。随着公司产品在先进封装、晶圆制造和显示面板等领域的持续渗透,以及产能的不断扩张,市场份额有望进一步提升。

根据国际半导体产业协会(SEMI)的数据,在半导体市场复苏行情下,以及高性能计算(HPC)和高带宽内存(HBM)等领域对先进材料的需求增加,2024年全球半导体材料市场规模预计达到674.7亿美元,同比增长3.8%。其中,晶圆制造材料市场规模为428.9亿美元,同比增长3.3%,封装材料市场规模为245.8亿美元。预计2025年全球半导体材料市场将增长5.4%,市场规模约711.3亿美元,其中,晶圆制造材料市场规模约增长5.5%,达到452.2亿美元,封装材料市场规模约259.1亿美元,增长5.4%。国内集成电路产业在汽车电子、消费电子、人工智能等的应用牵引下,2024年保持快速增长态势。

①集成电路湿电子化学品

公司的电镀液、光刻胶及配套试剂主要面向集成电路湿电子化学品市场。随着我国集成电路国产化进程的加深,在半导体工艺持续升级与下游应用领域的蓬勃发展的背景下,我国半导体材料行业将拥有广阔发展前景。根据中国电子材料行业协会(CEMIA)统计数据,2024年中国集成电路用湿化学品总体市场规模达到79.3亿元,同比增长10%,预计2025年将增长至86亿元。其中2024年中国集成电路前道晶圆制造(即前道工艺)用湿化学品市场规模64.5亿元,同比增长9.7%。预计2025年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模将增长至69.7亿元。2024年中国集成电路后道封装(即后道工艺,含传统封装与先进封装)用湿化学品市场规模14.8亿元,同比增长11.3%,随着晶圆制造工艺的不断提升,对与之配套的封测技术同步要求提高,传统封装技术的发展将趋于平稳,先进封装技术的应用将进一步加强,对湿化学品的需求也将随之增加,预计2025年中国集成电路后道工艺用湿化学品市场规模将达到16.3亿元。

②光刻胶市场

按曝光光源波长划分,光刻胶可分为g线光刻胶(436nm)、i线光刻胶(365nm)、KrF光刻胶(248nm)、ArF光刻胶(193nm)和EUV光刻胶(13.5nm)。根据中国电子材料行业协会的数据,当前我国g/i线光刻胶的国产化率20%-25%,仍处于较低水平,KrF光刻胶整体国产化率约3%,ArF光刻胶整体国产化率不足1%。

根据中国电子材料行业协会(CEMIA)统计数据,2024年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模为53.54亿元,预计到2025年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模将达到55.77亿元。其中,2024年中国集成电路晶圆制造用g/i线光刻胶市场规模5.78亿元,KrF光刻胶市场规模24.84亿元,ArF光刻胶市场规模4.43亿元,ArFi光刻胶市场规模10.12亿元,PSPI光刻胶市场规模8.37亿元。

2024年中国集成电路封装用光刻胶市场规模11.56亿元,预计到2025年市场规模将增长至12.25亿元。其中,2024年中国集成电路封装用g/i线光刻胶市场规模4.86亿元,PSPI光刻胶市场规模4.28亿元,其他光刻胶市场规模2.43亿元。

2024年中国OLED用光刻胶市场规模1.62亿元,预计2025年中国OLED用光刻胶市场规模将增长至1.95亿元。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年,中国半导体材料行业在技术突破、产业协同与生态重构的三重驱动下,实现了从“跟跑”向“并跑”的标志性跨越。新技术密集落地、新产业格局成型、新业态模式创新、新发展路径清晰,共同构建起半导体材料国产化的全新增长极。

①新技术:随着7nm及以下制程技术瓶颈显现,半导体产业正式进入“材料驱动”时代。?HBM3E、Chiplet 3D堆叠、CoWoS-L等先进封装技术的商业化应用,直接带动高纯电镀液、TSV/TGV添加剂等材料需求激增。公司构建的RDL/Bumping/TSV全工艺材料解决方案,已覆盖90%以上的国内封装厂,其中多款产品逐步进入规模性商业化阶段,验证周期较行业平均缩短,光刻胶国产化取得实质性进展。

②新产业:半导体材料企业加速从“产品供应商”向“系统级解决方案提供商”转型,“材料-设备-工艺”协同开发模式成为行业发展趋势。公司与设备商、晶圆厂联合攻关,通过同步开发材料配方与设备工艺参数,将产品导入周期缩短,并实现在头部客户供应链体系中的关键占位。另外,公司打通传统封装、先进封装与晶圆制造三大应用场景,提供覆盖电镀液、清洗液、光刻胶、配套试剂的全链条产品矩阵,形成难以复制的差异化竞争优势。同时,新材料应用场景不断拓展,产品供应从晶圆厂向存储厂延伸,市场空间得到进一步拓展。

③新业态:在国际技术壁垒与贸易摩擦的双重压力下,国内企业探索出“技术换市场”的全新产业范式。公司国际化布局成效显著,“中国研发+东南亚制造+全球销售”模式落地,海外收入占比提升至12.10%。公司与复旦大学、上海交通大学、同济大学、东南大学、北京理工大学、苏州大学等高校进行了一系列的合作,结合高校的人才优势、技术优势及丰富的科研资源,实现了技术、人才、资金和经营管理等要素的最佳组合。

④新模式:2025年,半导体材料行业当时“低价竞争”与“Me Too”模式,进入以?技术差异化、生态稳定性、供应链安全?为核心的高质量发展阶段。国产化路径清晰化?:在8英寸硅片、CMP抛光材料、刻蚀液等细分领域已实现进口替代,而在EUV光刻胶、12英寸硅片等高端材料上仍需攻坚,但技术差距正快速缩小。产业生态形成良性循环:在AI、新能源汽车等产业驱动下,下游客户主动加大本土材料供应商扶持力度,推动“验证-导入-放量”周期缩短,“需求拉动-技术反哺”的正循环效应显现。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,390,982,151.98	1,244,105,718.42	11.81	1,279,889,093.54
归属于上市公司股东的净资产	1,029,868,183.49	973,971,489.90	5.74	1,016,246,943.63
营业收入	592,643,701.23	432,188,410.38	37.13	360,039,281.45
利润总额	49,986,501.70	33,045,221.19	51.27	32,982,095.57
归属于上市公司股东的净利润	51,237,826.75	33,477,519.52	53.05	32,657,327.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,003,642.92	24,391,354.26	92.71	27,164,699.66
经营活动产生的现金流量净额	81,077,977.69	-24,718,612.25	不适用	-84,531,832.72
加权平均净资产收益率(%)	5.13	3.29	增加1.84个百分点	7.17
基本每股收益(元/股)	0.59	0.38	55.26	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.38	55.26	0.49
研发投入占营业收入的比例(%)	11.71	10.62	增加1.09个百分点	9.08

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	126,173,981.46	153,718,942.54	159,526,720.77	153,224,056.46
归属于上市公司股东的净利润	7,563,749.14	9,218,226.63	17,694,082.77	16,761,768.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,636,269.16	7,800,460.73	17,264,095.75	15,302,817.28
经营活动产生的现金流量净额	10,996,809.33	11,854,104.05	-4,790,808.50	63,017,872.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,601
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,918
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张兵	0	19,031,621	21.59	19,031,621	无	0	境内自然人
蔡卡敦	0	6,847,826	7.77	6,847,826	无	0	境内自然人
昆山艾森投资管理企业(有限合伙)	0	5,869,565	6.66	5,869,565	无	0	其他
鲁伟芳		1,890,665	2.15	0	无	0	境内自然人
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	-1,000,000	1,600,000	1.82	0	无	0	境内非国有法人
宁波艾龙创业投资合伙企业(有限合伙)	-3,876,966	1,459,002	1.66	0	无	0	其他
庄建华	-400,000	1,236,364	1.40	0	无	0	境内自然人
天津宸辉私募基金管理有限公司-天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,803,632	1,210,332	1.37	0	无	0	其他
江苏艾森半导体材料股份有限公司回购专用证券账户	-294,560	1,144,032	1.30	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)		995,300	1.13	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		张兵与蔡卡敦系夫妻关系;张兵为艾森投资普通合伙人及执行事务合伙人,持有艾森投资37.90%的财产份额;张兵、蔡卡敦和艾森投资为一致行动人。陈小华为宁波艾龙创业投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

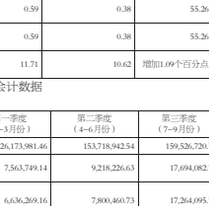
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

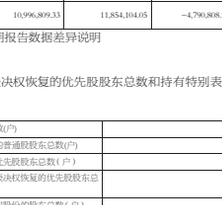
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,受益于半导体行业整体景气度回升,公司锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道,不仅在半导体封装化学品领域实现对国外供应商的规模化替代,稳固国内市场的核心主力供应商地位,在先进封装和晶圆领域的市场开拓也取得成效。报告期内,公司实现营业收入5.93亿元,同比增长37.13%。其中电镀液及配套试剂同比增长46.75%,光刻胶及配套试剂同比增长43.54%。归属于上市公司股东的净利润同比增长53.05%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长92.71%。主要经营情况详见本节“经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-015

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

根据目前经济环境及公司经营的总体情况,结合公司2026年度资金使用计划的需要,公司拟向银行等金融机构申请综合授信人民币30亿元额度,包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、开购贷款及项目贷款等形式,上述综合授信期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,授权公司财务总监或其指定的授权代理人在上述授信总额度内办理额度申请事宜,与银行签署相关合同及法律文件,并授权财务部办理相关手续。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,由财务总监确定并执行。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限